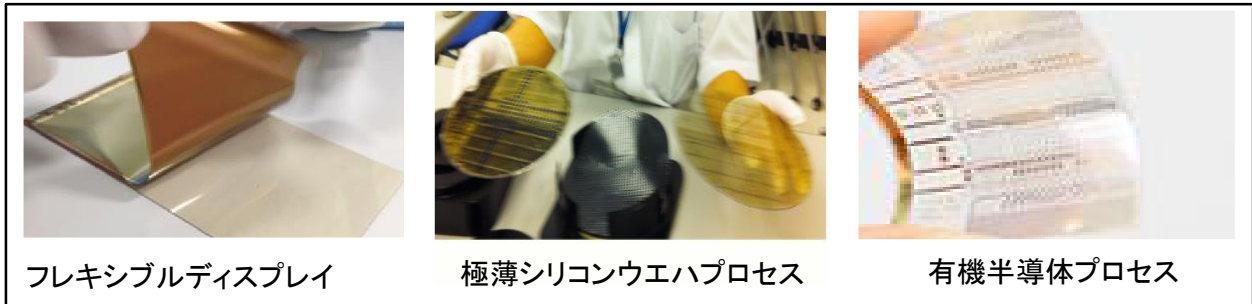


応用

フレキシブルディスプレイ後工程、LED製造、極薄シリコンウエハ工程において、露光プロセスにより形成されたデバイスを基板の裏からレーザーにより剥離するレーザーリフトオフ・プロセス(LLO)が使われるようになってきました。ポリイミドなどアブレーション加工出来る接合層であれば、ガラスやサファイヤなどレーザー光を透過する基板を用いてレーザー照射により瞬間的に界面の剥離が可能のため携帯電話のデバイス製造などで急速に用途が広がっています。



フレキシブルディスプレイ

極薄シリコンウエハプロセス

有機半導体プロセス

装置の特徴

本装置は固体UVパルスレーザーを用いて弊社独自の光学系により均一なラインビームを形成しワーク上の基板をステージで動かすことにより基板からデバイスを剥離するための装置です。剥離基板及びデバイスはロボットアームによりトレイに回収されます。

1. 固体レーザーを使った均一強度のラインビームにより安定した剥離プロセスを実現。
2. 毒ガスなどの付帯設備が不要で低価格で低ランニングコスト。
3. 大型基板(515mm x 510mm)対応

仕様

波長	355nm
ラインビームサイズ	100mm x 0.4mm
ビーム均一性	±5%(長軸)
照射エネルギー密度	30 ~300mJ/cm ² (ハリアプアッテネータにより制御)
ビームオーバーラップ	0%~95% (ステージ制御)
ワークサイズ	最大515mm x 510mm
処理能力	10分
装置サイズ	L2800 x W1900 x H2100

